

請求の範囲

- [請求項1] シリコンウェーハ研磨用組成物であって、
砥粒と、セルロース誘導体と、塩基性化合物と、水と、を含み、
前記研磨用組成物のゼータ電位は -24.0 mV 以上である、研磨用組成物。
- [請求項2] 前記セルロース誘導体の重量平均分子量は 80×10^4 よりも大きい、請求項1に記載の研磨用組成物。
- [請求項3] 前記セルロース誘導体の含有量は、前記砥粒100重量部に対して0.1～20重量部である、請求項1または2に記載の研磨用組成物。
- [請求項4] 前記塩基性化合物の含有量は0.001重量%以上0.1重量%未満である、請求項1から3のいずれか一項に記載の研磨用組成物。
- [請求項5] 前記研磨用組成物のpHは8.0以上12.0以下である、請求項1から4のいずれか一項に記載の研磨用組成物。
- [請求項6] 前記砥粒がシリカ粒子である、請求項1から5のいずれか一項に記載の研磨用組成物。
- [請求項7] 前記シリカ粒子の平均一次粒子径は5 nm以上100 nm以下である、請求項6に記載の研磨用組成物。
- [請求項8] シリコンからなる表面の研磨に用いられる、請求項1から7のいずれか一項に記載の研磨用組成物。
- [請求項9] シリコンウェーハの仕上げ研磨に用いられる、請求項1から8のいずれか一項に記載の研磨用組成物。
- [請求項10] シリコンウェーハを研磨する方法であって、
予備研磨工程と仕上げ研磨工程とを含み、
前記仕上げ研磨工程において、
砥粒と、セルロース誘導体と、塩基性化合物と、水と、を含み、
ゼータ電位が -24.0 mV 以上である研磨用組成物を用いて研磨対象基板を研磨する、研磨方法。